

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成17年4月7日(2005.4.7)

【公開番号】特開2003-280202(P2003-280202A)

【公開日】平成15年10月2日(2003.10.2)

【出願番号】特願2002-84074(P2002-84074)

【国際特許分類第7版】

G 03 F 7/039

H 01 L 21/027

【F I】

G 03 F 7/039 601

H 01 L 21/30 502 R

【手続補正書】

【提出日】平成16年5月27日(2004.5.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(a) 酸の作用による分解で離脱する基が、少なくとも1つのフッ素原子と環状構造とを含有する、酸の作用により分解してアルカリ水溶液に対する溶解性が向上する樹脂、
(b) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物、及び、
(c) 溶剤

を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【請求項2】

請求項1に記載のポジ型レジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。